

高压输入极低待机功耗 300mA LDO

简介

ET5H2XX 系列是高输入耐压且极低待机功耗的 300mA LDO，具有使能功能，输出电压范围为 1.8V~5V，专为需要超低静态电流的便携式电池供电应用而设计。2.5 μ A 的极低功耗确保了较长的电池寿命，动态瞬态提升特性提高了无线通信应用的设备瞬态响应。

ET5H2XX 系列提供 SOT89-3, SOT89-5, SOT23-5, SOT23-3, DNF4(1x1) 等不同封装。

特性

- 宽电压输入范围 2.5V至36V
- 最高300mA的带载能力输出
- 极低的静态 I_Q 典型值 2.5 μ A
- 具有EN关断功能
- 固定输出电压版本 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 5V
- 低压差值 1000mV @ 300mA负载且 $V_{OUT} = 3.3V$
- 具有优秀的电压/电流瞬态变化响应性能
- 电源纹波抑制比典型值: 60dB at 1KHz
- 提供 SOT89-3, SOT89-5, SOT23-5, SOT23-3, DFN4 (1mm x 1mm) 等不同的封装

产品信息

ET 5H2 XX X

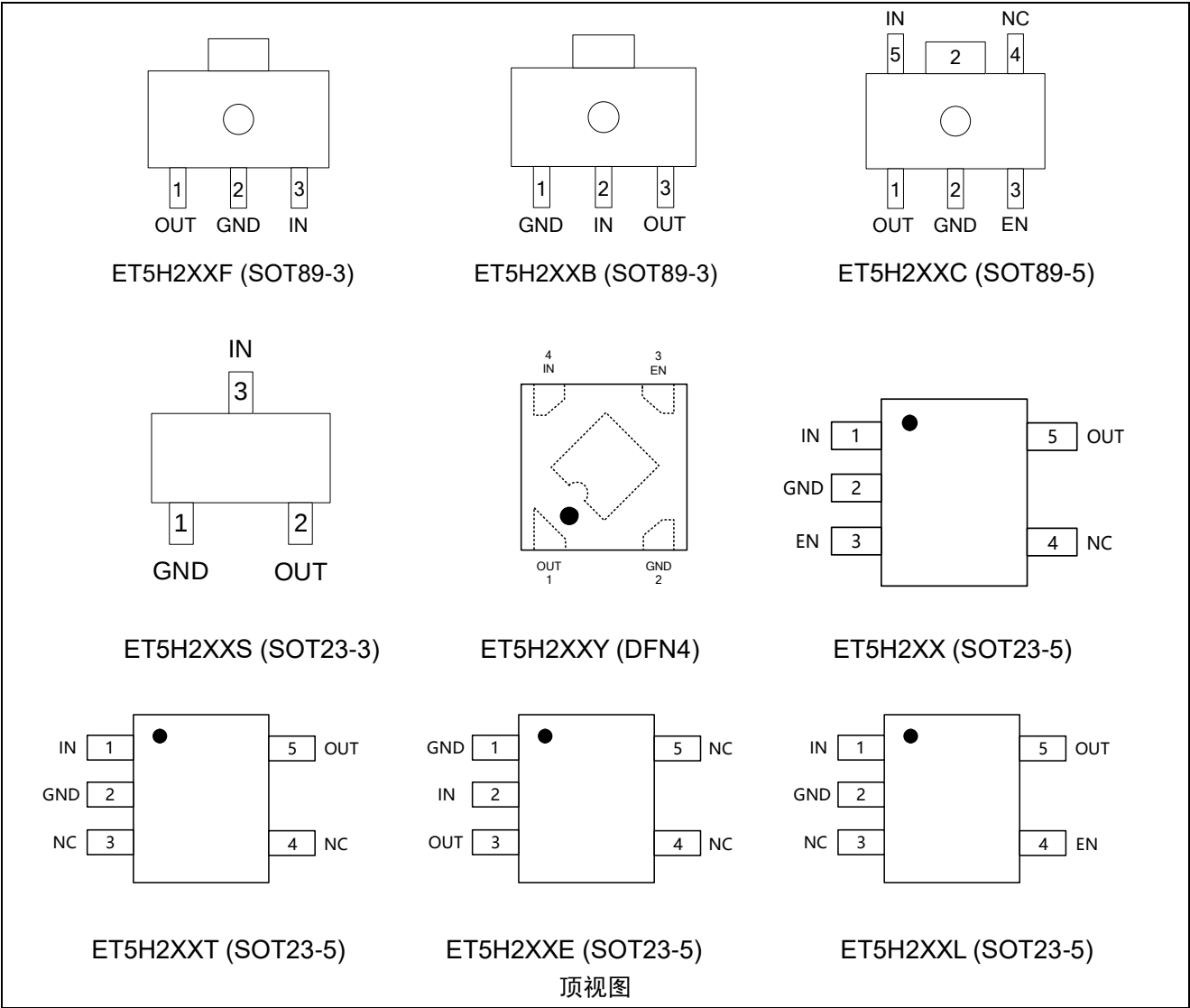
<u>XX</u> 输出电压		<u>X</u> 封装信息		最小包装信息	MSL
XX	输出电压 X.XV 例如, 18 为输出电压为 1.8V	B/F	SOT89-3	编带和卷盘, 1k	MSL3
		C	SOT89-5	编带和卷盘, 1k	MSL3
		Y	DFN4(1mm × 1mm)	编带和卷盘, 10k	MSL1
		S	SOT23-3	编带和卷盘, 3k	MSL3
		T/E/L	SOT23-5	编带和卷盘, 3k	MSL3
		/	SOT23-5 (缺省)	编带和卷盘, 3k	MSL3

ET5H2XX

标记信息

名称	打印标记									输出电压
	SOT89-3		SOT23-3	DFN4	SOT89-5	SOT23-5				
	XXB	XXF	XXS	XXY	XXC	XX	XXT	XXE	XXL	
ET5H218	18B	18F	18S	CX	18C	18	18T	18E	18L	1.8V
ET5H225	25B	25F	25S	FX	25C	25	25T	25E	25L	2.5V
ET5H228	28B	28F	28S	DX	28C	28	28T	28E	28L	2.8V
ET5H230	30B	30F	30S	GX	30C	30	30T	30E	30L	3.0V
ET5H233	33B	33F	33S	EX	33C	33	33T	33E	33L	3.3V
ET5H236	36B	36F	36S	RX	36C	36	36T	36E	36L	3.6V
ET5H250	50B	50F	50S	ZX	50C	50	50T	50E	50L	5.0V

管脚排列

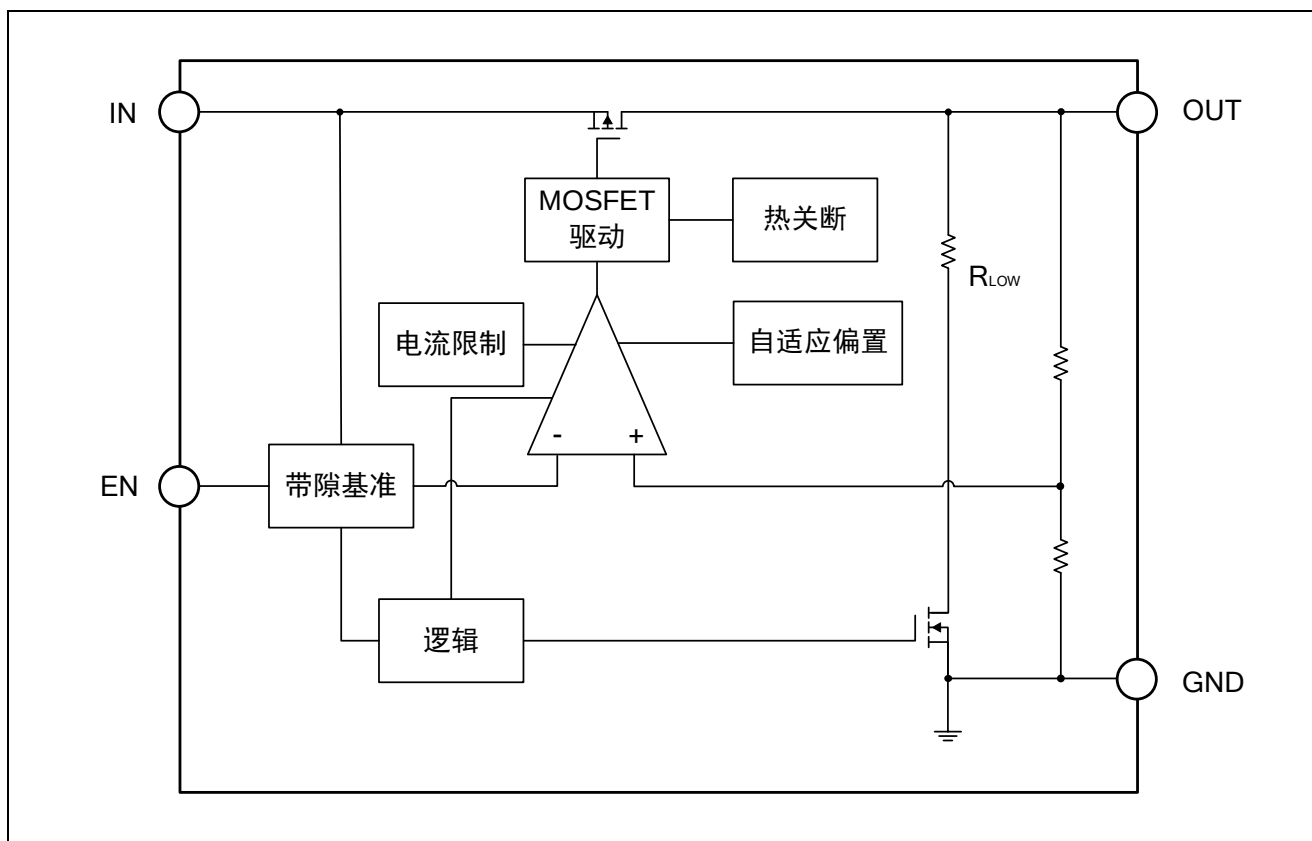


ET5H2XX

管脚说明

管脚编号									管脚名称	管脚功能
SOT89-3		SOT23-3	DFN4	SOT89-5	SOT23-5					
XXF	XXB	XXS	XXY	XXC	XX	XXT	XXE	XXL		
2	1	1	2	2	2	2	1	2	GND	接地管脚
3	2	3	4	5	1	1	2	1	IN	输入管脚
1	3	2	1	1	5	5	3	5	OUT	输出管脚
			3	3	3			4	EN	使能控制管脚
				4	4	3, 4	4, 5	3	NC	空脚

框图



功能说明

输入电容

建议在IN和GND引脚之间连接1 μ F至10 μ F的滤波电容，以消除输入电源电压的毛刺和噪声。电容量可无限增加。该输入电容必须尽可能靠近电路输入管脚以确保输入稳定且噪声较小。

对于PCB布局，IN和GND都需要较宽铜线以保证滤波效果。

输出电容

为了保证LDO的工作稳定性，需要在V_{OUT}和GND之间连接输出滤波电容。该滤波电容建议1 μ F至10 μ F，等效串联电阻(ESR)为5m Ω 至100m Ω ，温度特性为X7R或X5R。

ET5H2XX

较高的输出滤波电容值有助于改善负载/线路瞬态响应。可以增加输出电容值以保持低的下冲/过冲电压变化。建议该滤波电容尽可能靠近V_{OUT}和GND引脚。

EN 控制脚

ET5H2XX 在使能管脚(EN)设置为高时启用工作状态提供输出功率。当使能管脚(EN)设置为低则工作在禁用状态时，没有输出功率，待机静态电流几乎为零。EN 高电平有效。

低压差性能

ET5H2XX 使用 PMOS 来实现低压差。当(V_{IN} - V_{OUT})小于压降电压(V_{DO})时，PMOS 处于工作的线性区域，输入输出电阻为 PMOS 的 R_{DS(on)}。

V_{DO} 几乎与输出电流成比例，因为 PMOS 类似于一个电阻的衰减模式。与任何 LDO 一样，当(V_{IN} - V_{OUT})接近压降电压下限时，电源纹波抑制和瞬态响应会降低。

过温保护

当结温上升到约 155°C 时，过温保护功能启动将禁用 V_{OUT} 输出。禁用输出可消除 IC 消耗的功率，从而使 IC 冷却。当结温冷却到大约 130°C 时，输出电路再次启用。根据功耗、热阻和环境温度，过温保护电路可能会循环打开和关闭。这种循环限制了 LDO 的功率耗散，保护 LDO 不因过热而受损。

通常由(V_{IN}-V_{OUT})的电压差和负载电流的乘积超过最大耗散功率而激活过温保护功能。为确保可靠运行，应将 IC 的结温限制在 125°C。

耗散功率

对于连续工作条件下，不要超过绝对最高结温。最大功耗取决于 IC 封装的热阻、PCB 布局、周围气流的速率以及结和环境温度之间的差异。最大功耗可通过以下公式计算：

$$P_{D(MAX)} = (T_{J(MAX)} - T_A) / \theta_{JA}$$

公式中，T_{J(MAX)}是最高结温，T_A是环境温度，θ_{JA}是内部结对环境的热阻。

对于推荐的操作条件规格，最大结温为 150°C，T_A为环境温度。结与周围环境的热阻 θ_{JA} 取决于布板布局。对于 SOT89-3 封装，测试板上的热阻 θ_{JA} 为 135°C/W。T_A=25°C 时的最大功耗可通过以下公式计算：

$$P_{D(MAX)} = (150^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}) / (135^{\circ}\text{C} / \text{W}) = 0.925\text{W} \quad @ \text{SOT89-3 封装}$$

最大功耗取决于固定最大结温 T_{J(MAX)}和热阻 θ_{JA} 的工作环境温度。

限流保护

ET5H2XX 提供限流功能，防止设备在过载或短路情况下损坏。该电流由内部感应晶体管检测。

布局布板建议

- 将输入电容和输出电容尽可能靠近 IC 管脚。
- 管脚和散热片直接连接铜平面，以优化热性能。
- 在 IC 周围放置热通孔，以分配热量耗散。
- 请勿将热通孔直接放置在散热片连接 PCB 上。因为在焊接过程中，热通孔会将焊料或焊膏吸离散热片连接处，从而导致散热片接触不良。

ET5H2XX

极限参数

参数名称	参数描述	值	单位
V _{IN}	输入电压 ⁽¹⁾	-0.3 至 44	V
V _{OUT}	输出电压	-0.3 至 6	V
V _{EN}	使能管脚电压	-0.3 至 44	V
T _{J(MAX)}	最大结温	150	°C
T _{STG}	贮存温度	-65 至 150	°C
V _{ESD} ⁽²⁾	人体放电模型 (HBM)	±2000	V
	充电器件放电模型 (CDM)	±1500	V
I _{LU} ⁽²⁾	门锁电流最大额定值	±200	mA

使用超过极限参数值表中列出的值可能会损坏 IC。如果超过这些限制中的任何一个参数, 则 IC 的功能可能会发生损坏, 并可能影响 IC 可靠性。

注释 1. 有关安全操作区域, 请参阅电气特性和应用信息。

注释 2. 该设备系列采用 ESD 保护, 并通过以下方法进行测试:

人体放电模型 (HBM)测试标准: JEDEC JS-001;

充电放电模型 (CDM)测试标准: JEDEC JS-002;

门锁电流最大额定值测试标准: JEDEC78F。

热参数表

参数名称	封装	参数描述	值	单位
R _{θJA}	SOT89-3	结至环境热阻	135	°C/W
	SOT89-5		125	
	SOT23-5		250	
	SOT23-3		360	
	DFN4		250	
P _D	SOT89-3	功耗@25°C PCB 板尺寸: 40mm x 40mm (2 层) 覆铜:1OZ	920	mW
	SOT89-5		1000	
	SOT23-5		500	
	SOT23-3		420	
	DFN4		500	

建议使用条件

参数名称	参数描述	值	单位
V _{IN}	输入电压	2.5 至 36	V
I _{OUT}	输出电流	0 至 300	mA
T _J	工作结温	-40 至 125	°C
C _{IN}	有效输入电容	1 至 10	μF
C _{OUT}	有效输出电容	1 至 10	μF
ESR	输入和输出电容器等效串联电阻	5 至 100	mΩ

ET5H2XX

电参数表

($V_{IN} = V_{OUT} + 2V$; $I_{OUT} = 1mA$, $C_{IN} = C_{OUT} = 1.0\mu F$, 除非另有说明. 典型值条件为 $T_A = +25^{\circ}C$ 。)

参数名称	参数描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	工作输入电压 ⁽³⁾		2.5		36	V
V_{OUT}	输出电压追踪准确度	$I_{OUT} = 1mA, 25^{\circ}C$	-2%		+2%	V
		$I_{OUT} = 1mA, -40\sim 125^{\circ}C$	-3%		+3%	
I_Q	静态电流	$I_{OUT} = 0mA, 25^{\circ}C$		2.5	4.5	μA
I_{Q_OFF}	关断电源电流	$V_{EN} = 0V$ (If EN Pin Exist), $25^{\circ}C$		0.1	1	μA
$Line_{REG}$	线性调整率 ⁽⁶⁾	$V_{IN} = V_{OUT} + 2V$ 至 $36V$, $I_{OUT} = 10mA$ ($\Delta V_{OUT} / \Delta V_{IN} / V_{OUT}$)		0.05	0.20	%/V
$Load_{REG}$	负载调整率 ⁽⁶⁾	$1mA \leq I_{OUT} \leq 300mA$, $V_{IN} = V_{OUT} + 2V$			40	mV
V_{DROP}	压降电压 $I_{OUT}=300mA$ ^{(4) (6)}	$V_{OUT} = 1.8V$		1350	1650	mV
		$V_{OUT} = 2.5V$		1150	1450	
		$V_{OUT} = 2.8V$		1100	1400	
		$V_{OUT} = 3.0V$		1050	1350	
		$V_{OUT} = 3.3V$		1000	1300	
		$V_{OUT} = 3.6V$		950	1250	
		$V_{OUT} = 5V$		900	1200	
I_{LMT}	输出电流限制	$V_{IN} = V_{OUT} + 2V$	350	450		mA
V_{ENH}	器件使能电压范围	EN Input Voltage "H" (If EN Pin Exist)	1.2			V
V_{ENL}	器件禁用电压范围	EN Input Voltage "L" (If EN Pin Exist)			0.4	V
I_{EN}	使能引脚漏电流	$V_{EN} = 0$ 至 $36V$		1		μA
PSRR	电源纹波抑制 ⁽⁵⁾	$f = 1 kHz$, $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ $I_{OUT} = 20mA$		60		dB
ϵ_N	输出噪声电压 ⁽⁵⁾	$V_{IN} = V_{OUT} + 2V$, $I_{OUT} = 1mA$, $f = 10Hz$ 至 $100KHz$, $V_{OUT} = 3V$, $C_{OUT} = 1\mu F$		100		μV_{rms}
T_{SD}	结关断温度 ⁽⁵⁾	温度从 $T_A = +25^{\circ}C$ 开始升高		155		$^{\circ}C$
T_{SDH}	热关断迟滞 ⁽⁵⁾	温度从结关断温度开始降低		30		$^{\circ}C$

注释 3. V_{IN} 是指芯片内部逻辑电路可以正常工作的范围。如果 $V_{IN} < V_{OUT}$, V_{OUT} 将跟随 $V_{IN}(I_{OUT} = 1mA)$, 但电路是正常的。

注释 4. V_{DROP} FT 测试方法: 测试 V_{OUT} 输出电压在 $V_{SET} + V_{DROP_{MAX}}$ 且 300mA 输出电流下。

注释 5. 由设计保证, 不是 FT 测试项目。

注释 6. 在高温下, 最大负载电流可按以下 公式计算:

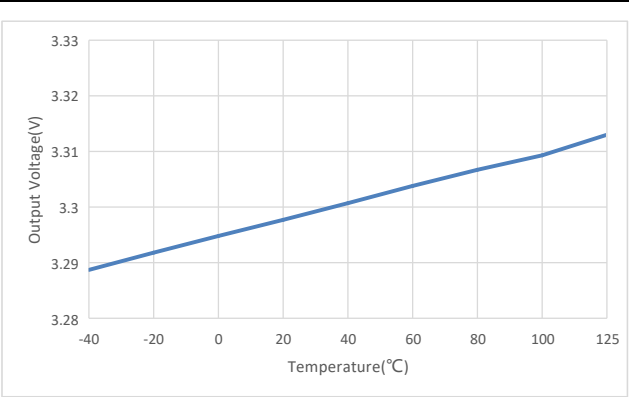
$$I_{OUT_MAX} = (T_J - T_A) / R_{\theta JA} / (V_{IN} - V_{OUT})$$

ET5H2XX

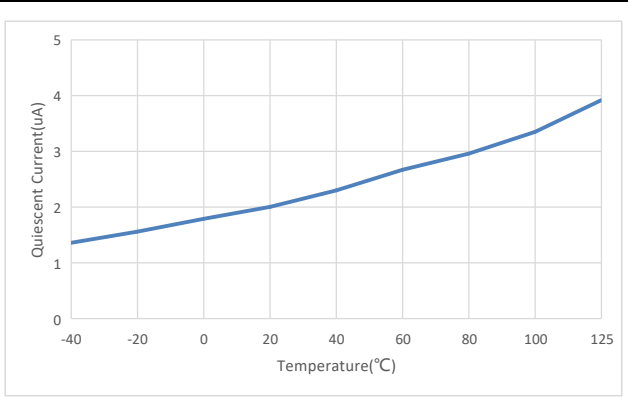
典型特性图

电压版本 3.3V

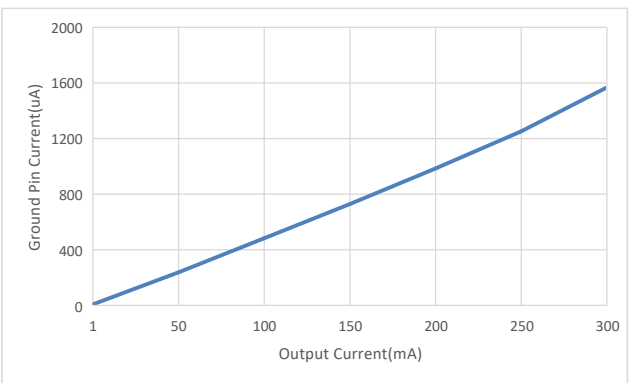
($V_{IN} = V_{OUT} + 2V$, $I_{OUT} = 1mA$, $C_{IN} = C_{OUT} = 1.0\mu F$, 除非另有说明, 典型值条件为 $T_A = +25^{\circ}C$ 。)



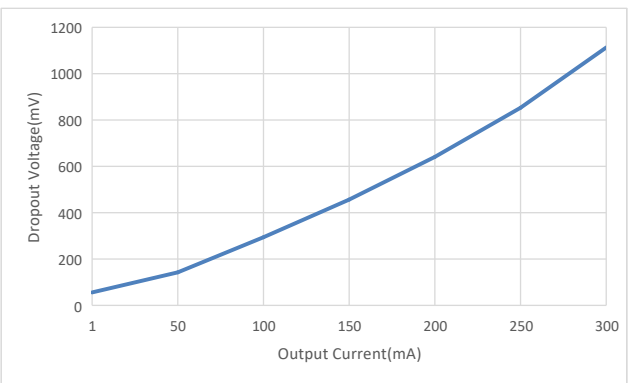
输出电压与温度间的关系, 其中 $I_{OUT} = 1mA$



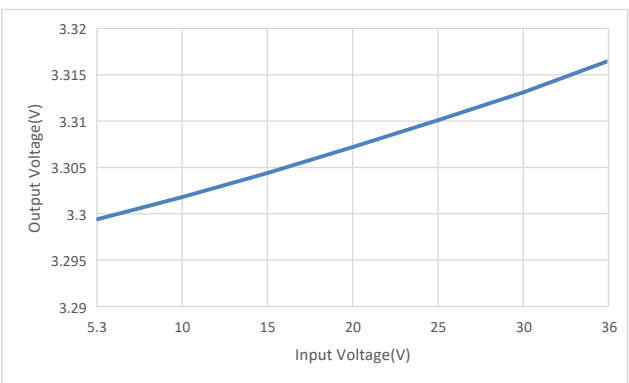
静态电流与温度间的关系



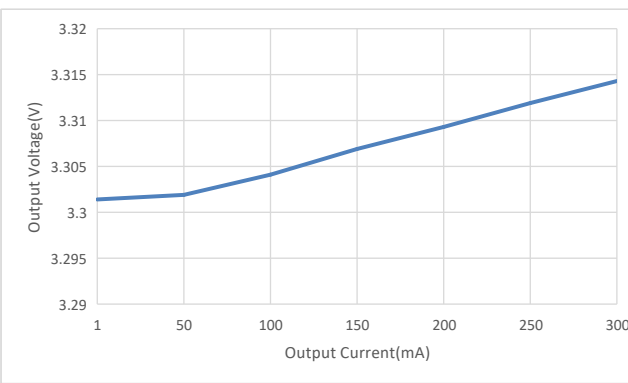
接地电流与负载电流间的关系



压降电压与负载电流间的关系



输出电压与输入电压间的关系, 其中 $I_{OUT} = 1mA$



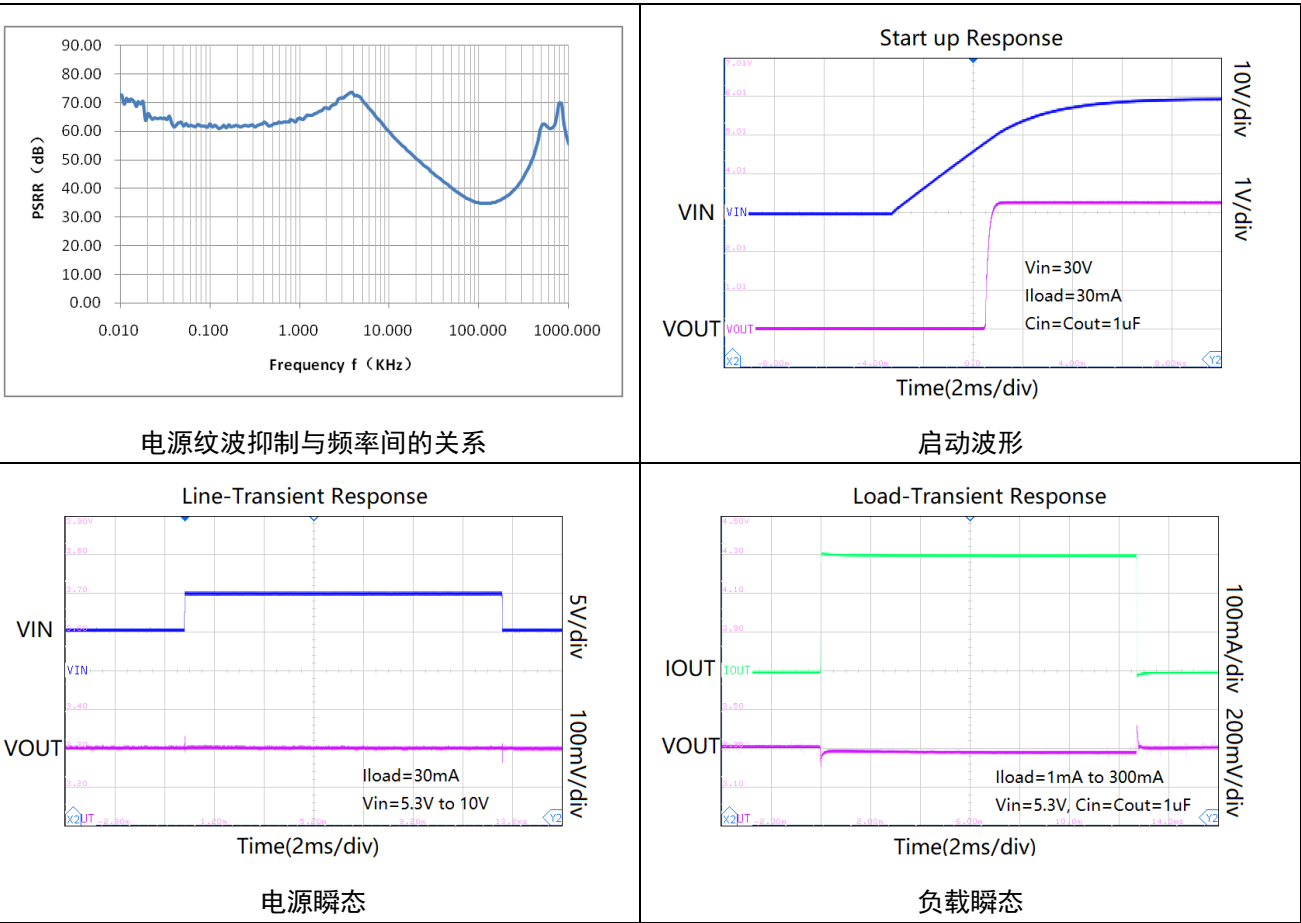
输出电压与负载电流间的关系

ET5H2XX

典型特性图(续)

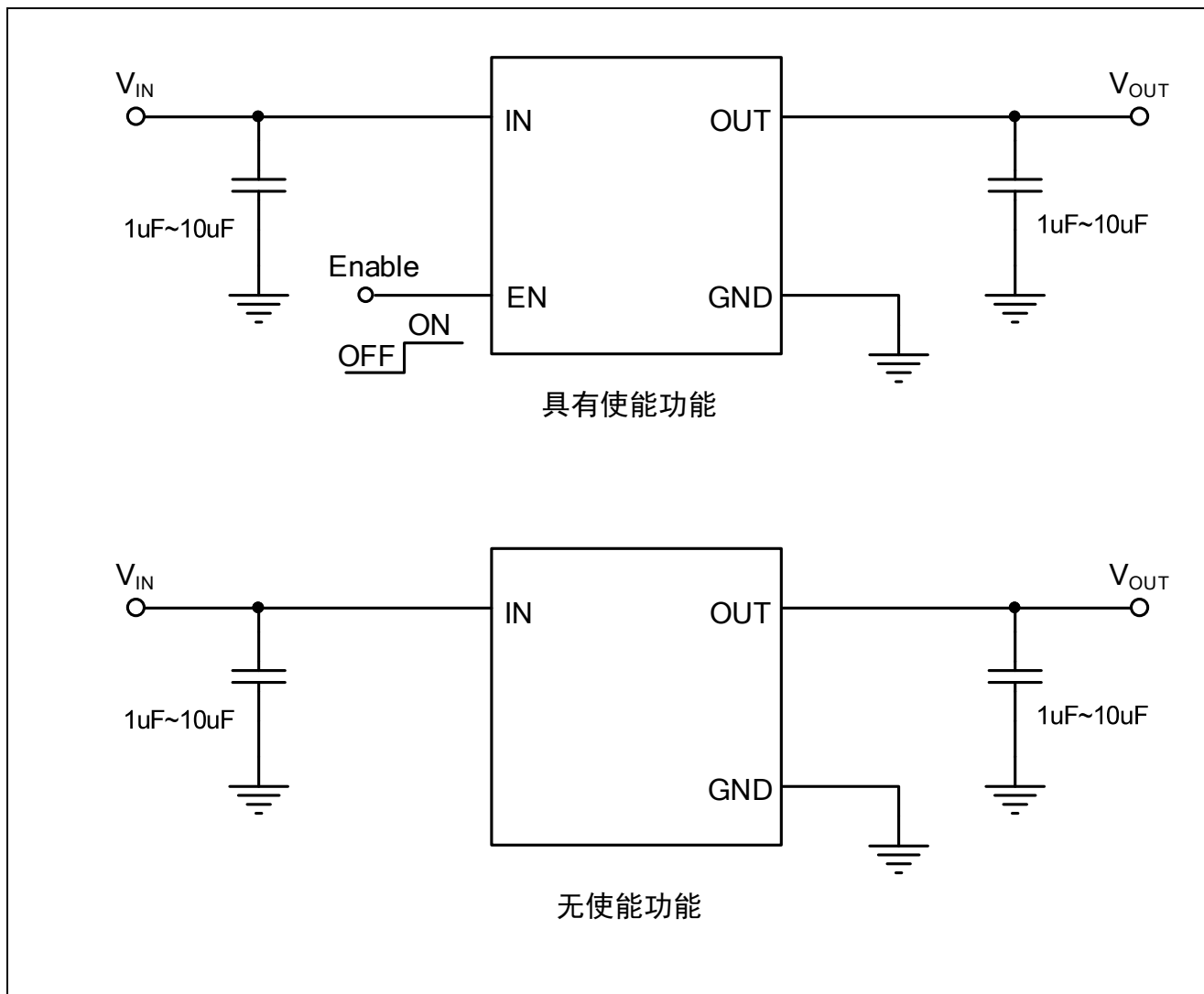
电压版本 3.3V

($V_{IN} = V_{OUT} + 2V$, $I_{OUT} = 1mA$, $C_{IN} = C_{OUT} = 1.0\mu F$, 除非另有说明, 典型值条件为 $T_A = +25^{\circ}C$ 。)



ET5H2XX

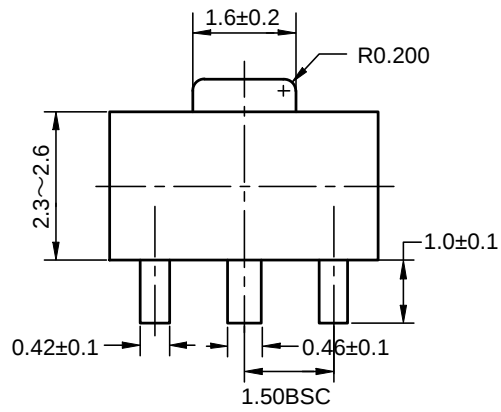
参考应用图



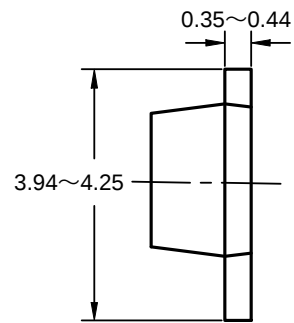
ET5H2XX

封装信息

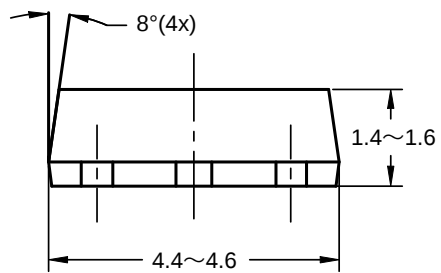
SOT89-3



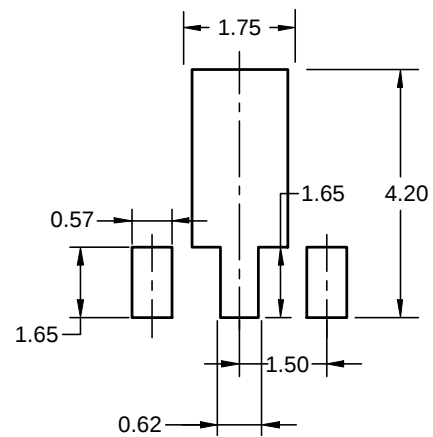
Top View



Side View



Side View

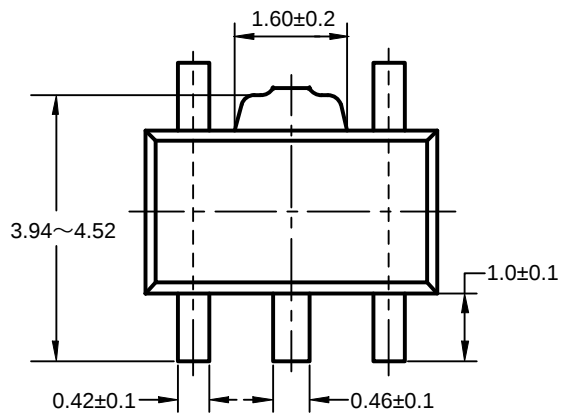


Recommended Land Pattern

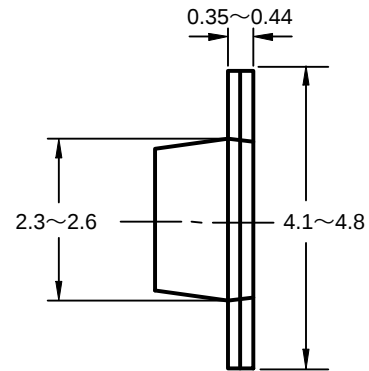
Unit: mm

ET5H2XX

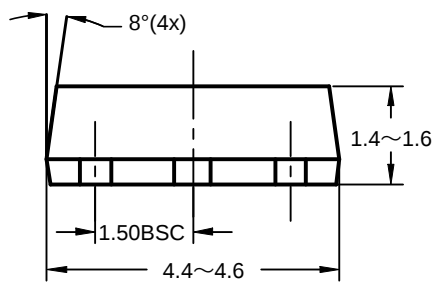
SOT89-5



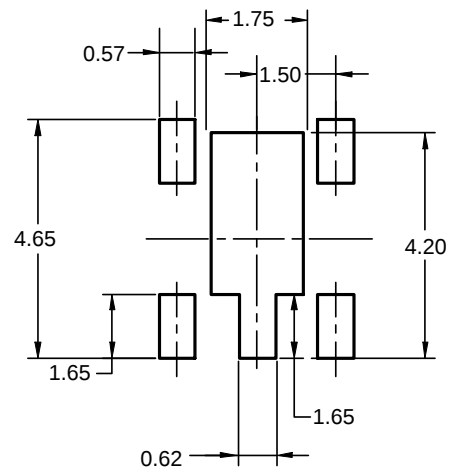
Top View



Side View



Side View

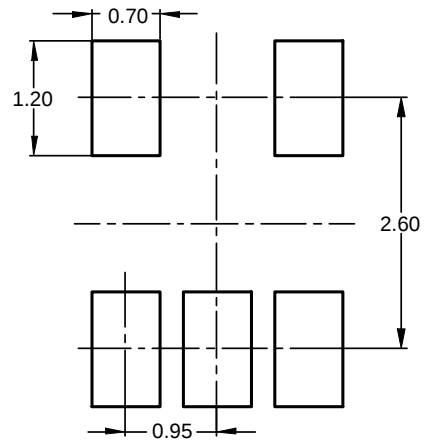
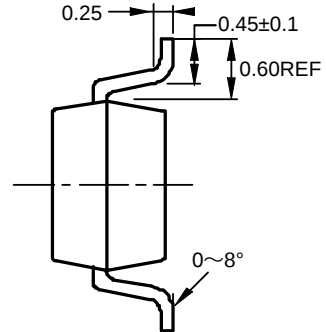
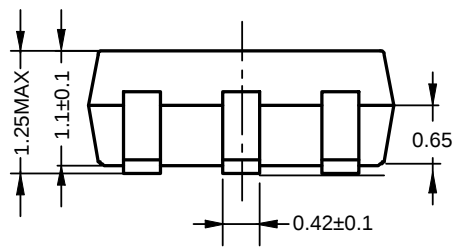
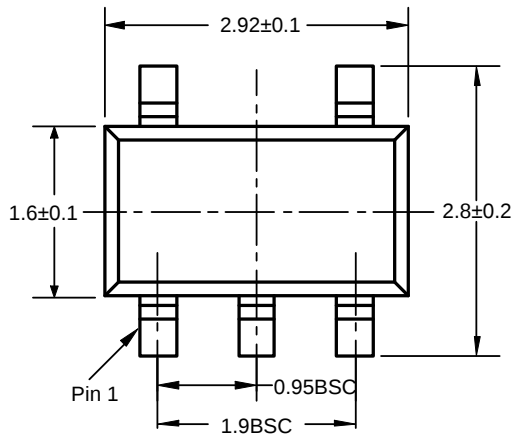


Recommended Land Pattern

Unit: mm

ET5H2XX

SOT23-5

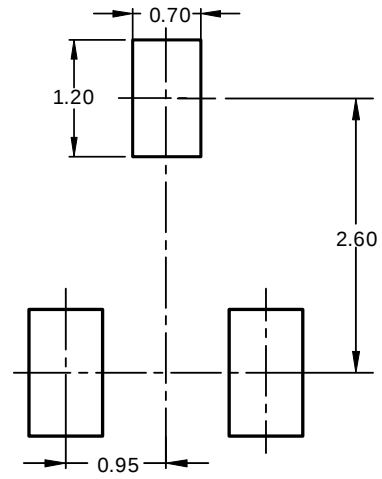
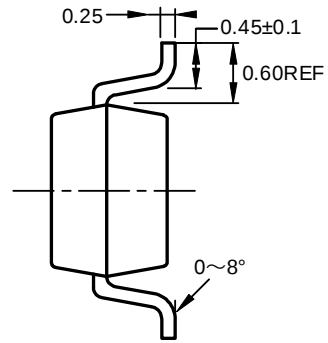
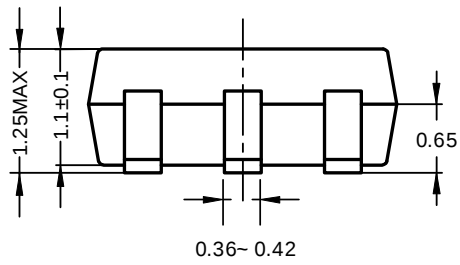
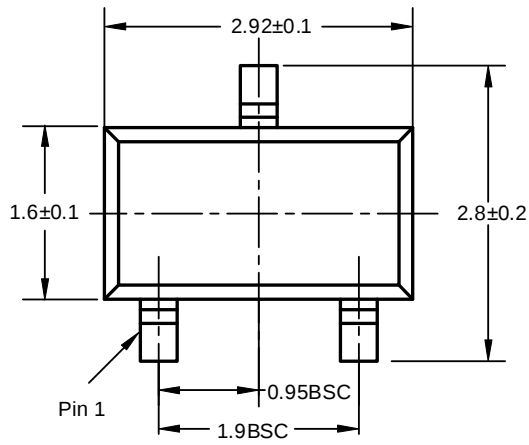


Recommended Land Pattern

Unit: mm

ET5H2XX

SOT23-3

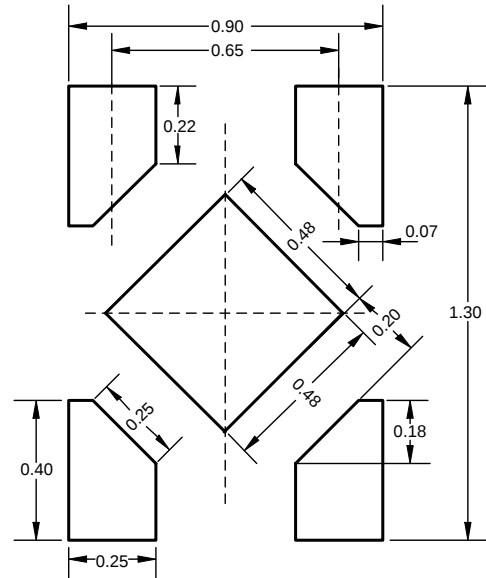
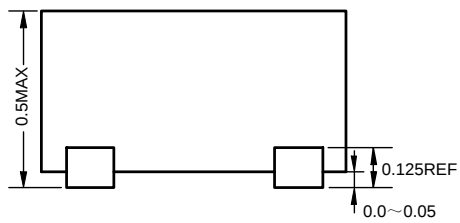
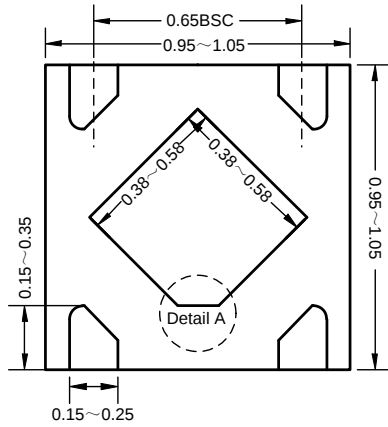


Recommended Land Pattern

Unit: mm

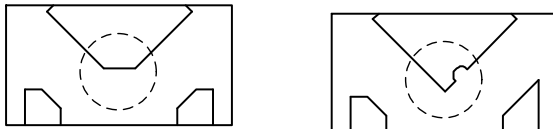
ET5H2XX

DFN4(1mm x 1mm)



Recommended Land Pattern

Detail A: (PIN1 shape)

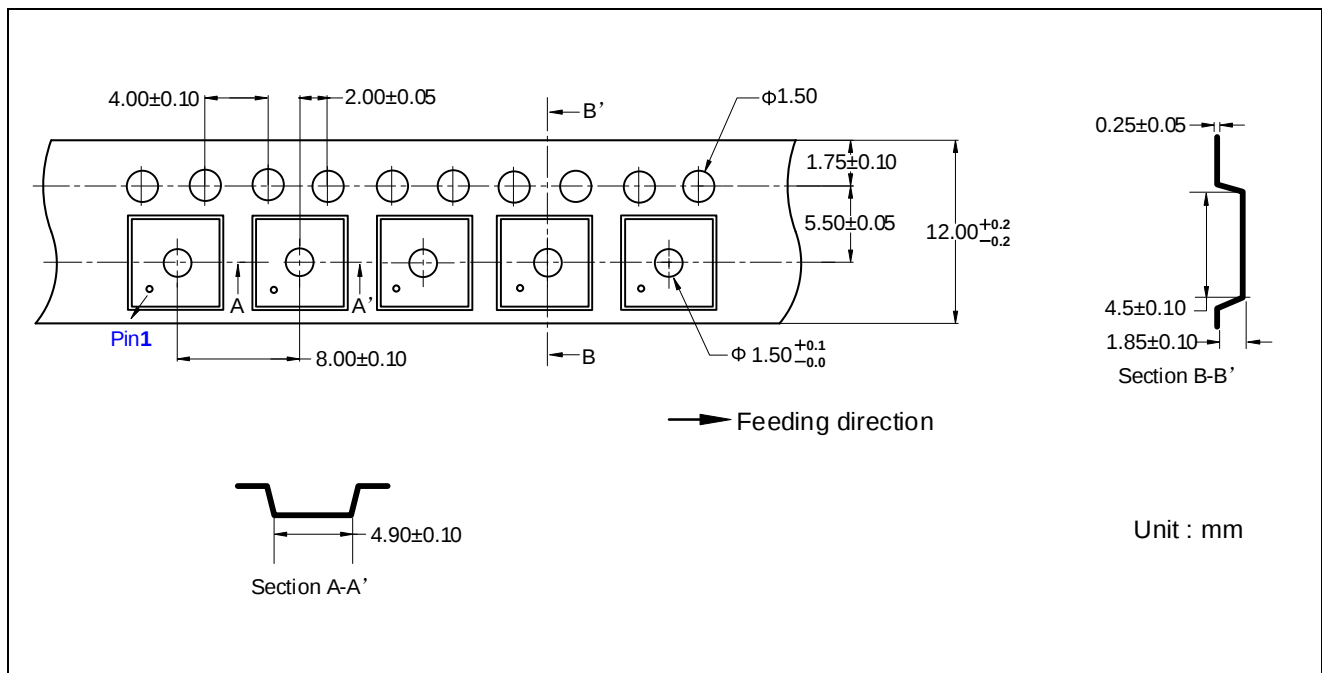


Unit: mm

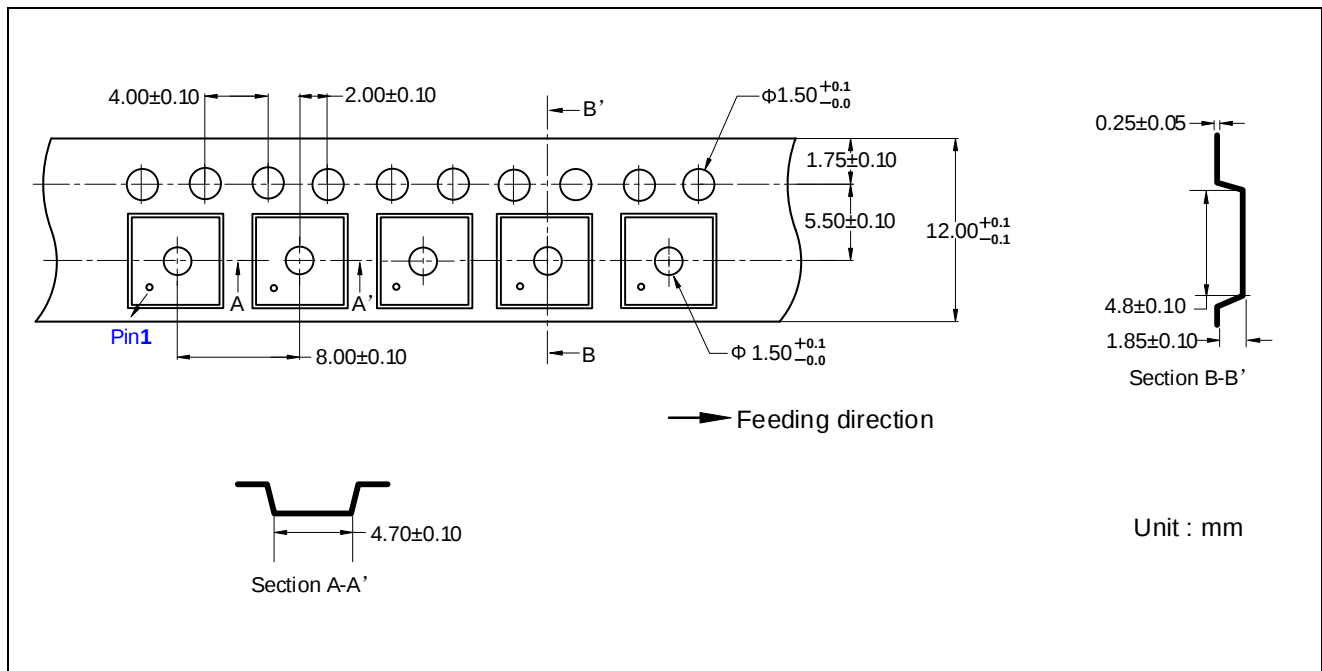
ET5H2XX

编带信息

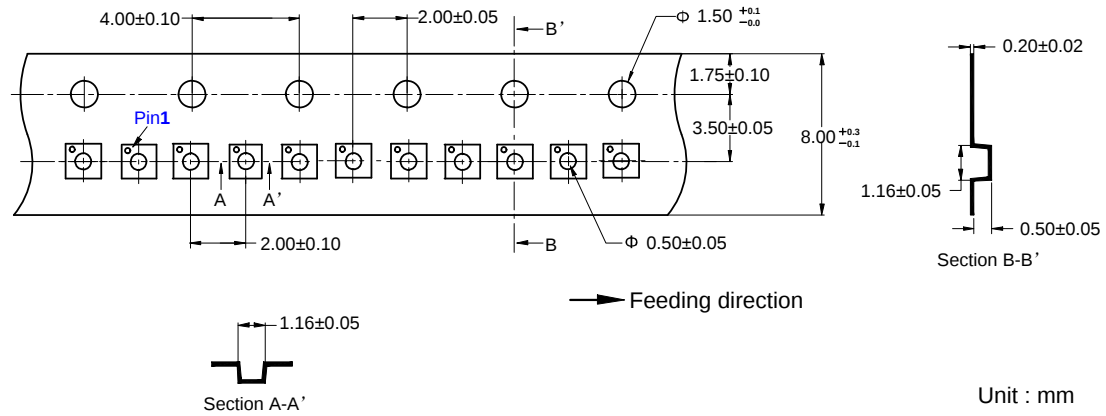
SOT89-3



SOT89-5

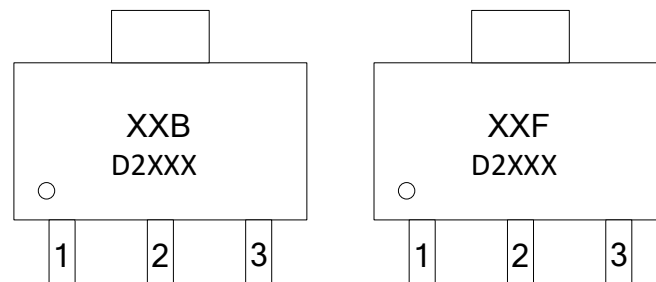


DFN4



丝印信息

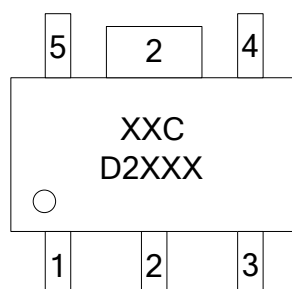
SOT89-3



XXB/XXF - Part Number
D2XXX - Tracking Number

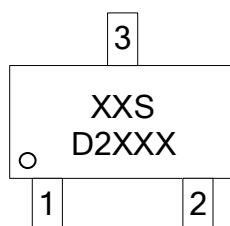
ET5H2XX

SOT89-5



XXC - Part Number
D2XXX - Tracking Number

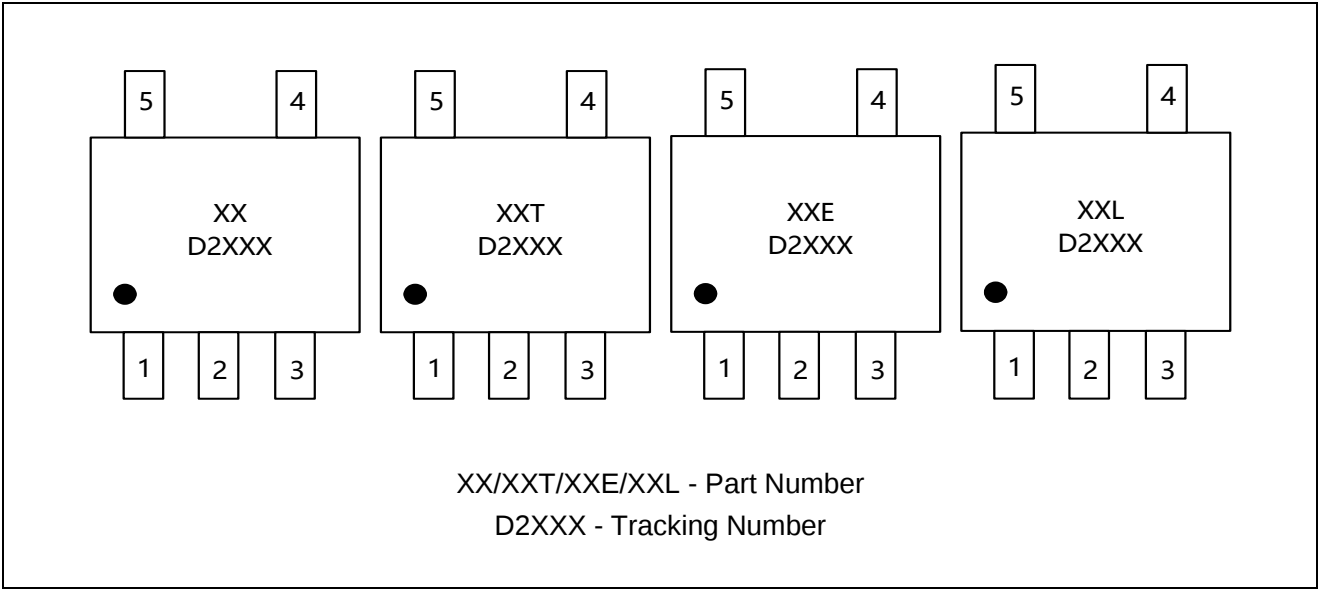
SOT23-3



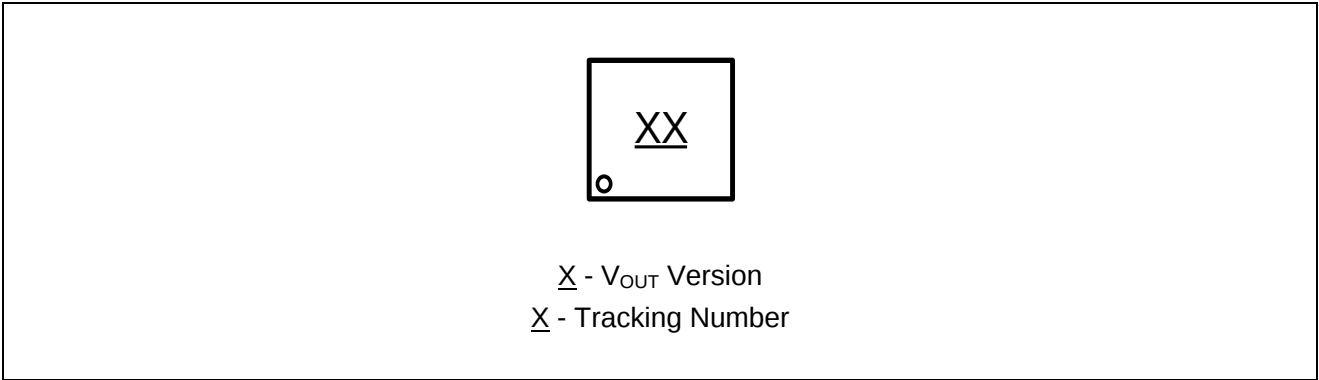
XXS - Part Number
D2XXX - Tracking Number

ET5H2XX

SOT23-5



DFN4



修订历史和检查表

版本	日期	修订项目	排版	功能及格式检查	封装及编带检查
1.0	2020-12-28	中文版本	石波	刘晓敏	刘佳莹
1.1	2022-03-22	更新丝印	石波	刘晓敏	刘佳莹
1.2	2025-05-20	全文格式更新	彭俊杰	刘晓敏	刘佳莹